(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
23. Oktober 2003 (23.10.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/088323 A1

(51) Internationale Patentklassifikation[7]: H01L 21/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/03937

(22) Internationales Anmeldedatum:
15. April 2003 (15.04.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 16 786.9 15. April 2002 (15.04.2002) DE

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **ERS ELECTRONIC GMBH** [DE/DE]; Stettiner Str. 3 + 5, 82110 Germering (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **REITINGER, Erich** [DE/DE]; Nymphenburger Strasse 90c, 80636 München (DE).

(74) Anwalt: **BARTH, Stephan**; Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR, Friedrichstr. 31, 80801 München (DE).

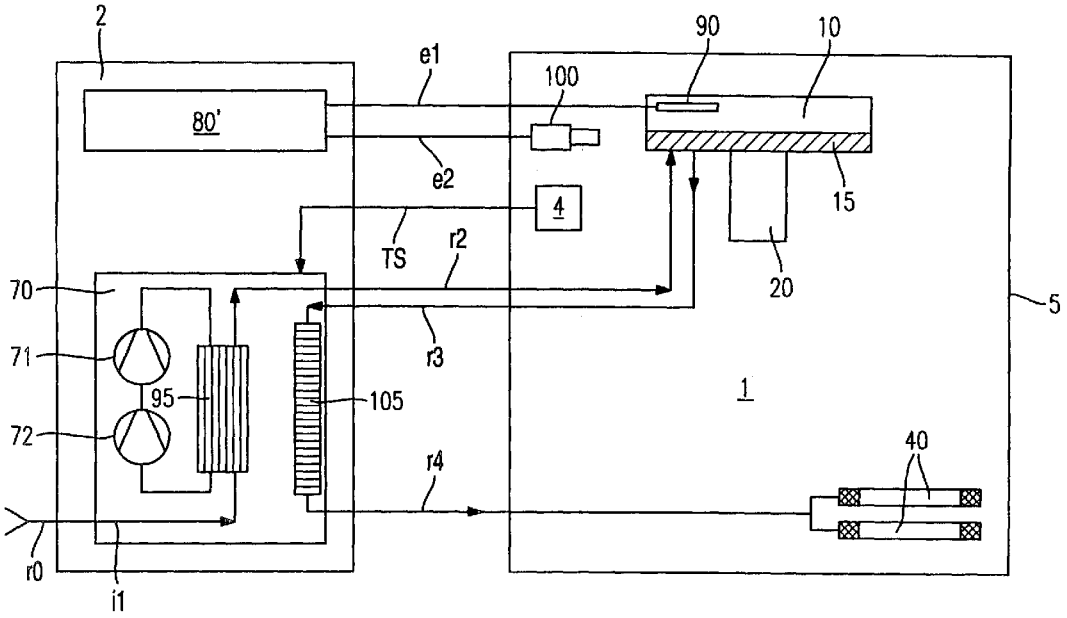
(81) Bestimmungsstaaten *(national)*: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(regional)*: ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CONDITIONING SEMICONDUCTOR WAFERS AND/OR HYBRIDS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KONDITIONIERUNG VON HALBLEITERWAFERN UND/ODER HYBRIDEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for conditioning semiconductor wafers and/or hybrids, comprising the following steps: an at least partly closed space (1) containing a wafer/hybrid-receiving unit (10) is provided for receiving a semiconductor wafer and/or hybrid; and a dry fluid is directed through the wafer/hybrid-receiving unit (10) in order to temper the wafer/hybrid-receiving unit (10), at least part of the fluid leaving the wafer/hybrid-receiving unit (10) being used for conditioning the atmosphere inside the space (1). Also disclosed is a corresponding device for conditioning semiconductor wafers and/or hybrids.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/088323 A1

Veröffentlicht:
— *mit internationalem Recherchenbericht*
— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden mit den Schritten: Bereitstellen eines zumindest teilweise geschlossenen Raums (1) mit einer darin befindlichen Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zur Aufnahme eines Halbleiterwafers und/oder Hybrids; und Leiten eines trockenen Fluids durch die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) zum Temperieren der Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10); wobei zumindest ein Teil des die Wafer/Hybrid-Aufnahmeeinrichtung (10) verlassenden Fluids zum Konditionieren der Atmosphäre innerhalb des Raums (1) verwendet wird. Die Erfindung schafft auch eine entsprechende Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern und/oder Hybriden.